



TPV591: Transistor RF NPN Silicon Power 300mA 45v



Descripción

Nombre: TRANSISTOR RF NPN SILICON POWER 300MA 45V TRANSISTOR DE POTENCIA RF DE SILICIO NPN **Referencia:** TPV591

- ICMáx.: 300 mA
- Voltaje VCB: 45 V
- Máxima Potencia Disipada: 5.3 W @ TC = 25 OC
- Temperatura de unión TJ: -55°C a +200°C
- Temperatura de almacenamiento: TSTG -55°C a +200°C

Marca: Motorola **Empaque:** 25 4L STUD **Precio por:** Unidad **Ficha técnica:** [TPV591\(ASI\)](#)

Información del producto

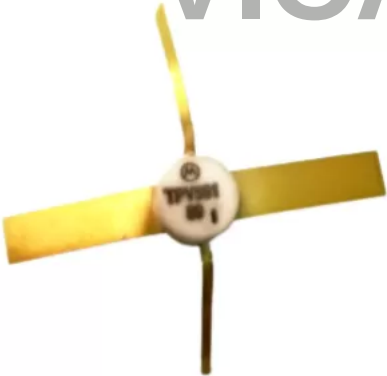
Descripción: TRANSISTOR RF NPN SILICON POWER 300MA 45V Marca: MOTOROLA. Referencia: TPV591 El TPV591 es un transistor con emisor común diseñado para transmisores de televisión de alta linealidad Clase A Banda IV y V.

Precio: \$125.493 IVA INCLUIDO

SKU: 9-11-19

Categorías: [RF TRANSISTORES Y MOSFETS](#), [SEMICONDUCTORES](#)

Etiquetas: [0090011000019](#), [9-11-19](#), [ADVANCED SEMICONDUCTOR](#), [MOTOROLA](#), [RF TRANSISTORES Y MOSFETS](#), [SEMICONDUCTORES](#), [TPV591](#), [TRANSISTOR RF NPN](#)



TPV591

ASI TPV591

NPN SILICON RF POWER TRANSISTOR

DESCRIPTION:
The **ASI TPV591** is a Common Emitter Transistor designed for high linearity Class A operation in the 40-100 MHz range.

FEATURES INCLUDE:
• Good Linearity
• Good Reliability

MAXIMUM RATINGS

Symbol	Value	Unit
$I_{C_{max}}$	300	mA
$V_{CE_{max}}$	45	V
$P_{D_{max}}$	5.3 W @ $T_C = 25^\circ C$	
f_T	100	MHz
f_{max}	100	MHz
$R_{DS_{on}}$	200	Ω

PACKAGE STYLE: 25 4L STUD

CHARACTERISTICS

Symbol	Test Conditions	Minimum	Typical	Maximum	Units
$I_{C_{sat}}$	$V_{CE} = 10 V, I_B = 10 mA$	200			mA
$I_{C_{sat}}$	$V_{CE} = 10 V, I_B = 10 mA$	40			mA
$I_{C_{sat}}$	$V_{CE} = 10 V, I_B = 10 mA$	0.5			mA
f_T	$V_{CE} = 10 V, I_C = 10 mA$	100			MHz
f_{max}	$V_{CE} = 10 V, I_C = 10 mA$	100			MHz
$R_{DS_{on}}$	$V_{CE} = 10 V, I_C = 10 mA$	200			Ω
$R_{DS_{on}}$	$V_{CE} = 10 V, I_C = 10 mA$	200			Ω
$R_{DS_{on}}$	$V_{CE} = 10 V, I_C = 10 mA$	200			Ω

ADVANCED SEMICONDUCTOR